## PLASMA GENERATING POWER SOURCE DEVICE

Publication number: JP11288796 **Publication date:** 

1999-10-19

Inventor:

KUZUMOTO MASAKI; WADA NOBORU; TABATA

YOICHIRO

Applicant:

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

Classification:

- international:

H05H1/24; H02M9/06; H05H1/24; H02M9/00; (IPC1-7):

H05H1/24; H02M9/06

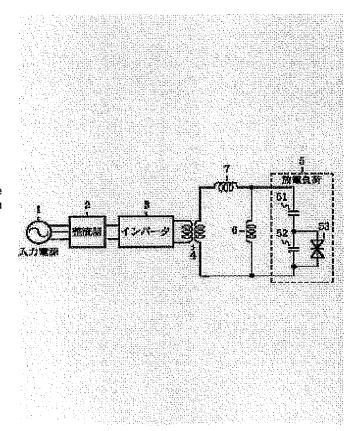
- european:

Application number: JP19980087288 19980331 Priority number(s): JP19980087288 19980331

Report a data error here

#### Abstract of **JP11288796**

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a small-sized and inexpensive power source device with a high power factor by providing a parallel inductor and a serial inductor to a discharge load for exciting a gas by discharge to generate a plasma. SOLUTION: The commercial AC voltage of an input power source 1 is converted to DC by a rectifier 2, and further converted into an AC voltage of a regulated frequency by an inverter 3. This voltage is further raised to a voltage leading to a discharge start by a transformer 4 to apply a high voltage to a discharge load 5, a discharge is generated in the discharge load 5 to excite a gas particle. By connecting not only a parallel inductor 6 but also a serial inductor 7 to the discharge load 5, the improving degree of power factor is improved more than in the simple connection of the parallel inductor 6. When the inductances of both the inductors are values satisfying a prescribed expression, particularly, a power factor of about 90% can be provided by the resonance with the composed capacity of the discharge load 5.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

#### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

#### (11)特許出願公開番号

# 特開平11-288796

(43)公開日 平成11年(1999)10月19日

(51) Int.Cl. 6

識別記号

FΙ

H05H 1/24 H02M 9/06 H05H 1/24

H02M 9/06

D

審査請求 未請求 請求項の数14 OL (全 11 頁)

(21)出顯番号

特願平10-87288

(71)出願人 000006013

三菱電機株式会社

(22)出願日

平成10年(1998) 3月31日

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

(72)発明者 葛本 昌樹

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三

菱電機株式会社内

(72)発明者 和田 昇

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三

菱電機株式会社内

(72)発明者 田畑 要一郎

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三

菱電機株式会社内

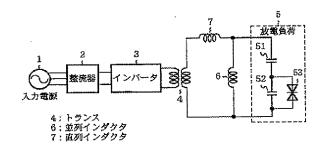
(74)代理人 弁理士 田澤 博昭 (外1名)

## (54) 【発明の名称】 プラズマ発生用電源装置

## (57)【要約】

【課題】 力率が高く、小型で安価な電源システムを提供する。

【解決手段】 放電負荷5に力率補償用の並列インダクタ6と力率補償用の直列インダクタ7を接続する。特に、放電負荷5の合成容量と共振するように並列インダクタ6、直列インダクタ7のインダクタンスを設定することにより、力率改善度合いを高く設計することができる。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 2つの電極間で等価的に誘電体静電容量とガス静電容量とを有し、放電してガスを励起し、ブラズマを発生させる放電負荷に対し、トランスを介して交流電力を供給するブラズマ発生用電源装置において、前記放電負荷に対して並列に接続された並列インダクタと、

前記放電負荷に対して直列に接続された直列インダクタ とを備えたことを特徴とするプラズマ発生用電源装置。

【請求項2】 並列インダクタ及び直列インダクタをト\*10

 $Lp=Ls=(C1+C2)/(C1\times C2\times (2\pi f)^2)$ 

但し、Lp:並列インダクタのインダクタンス

Ls: 直列インダクタのインダクタンス

C1:誘電体静電容量の値

〇:ガス静電容量の値

f:交流電力の周波数

【請求項5】 直列インダクタはトランスの漏れインダクタンスを利用したものであることを特徴とする請求項 1から請求項4のうちのいずれか1項記載のプラズマ発※

 $Ls=1/(C1(2\pi f)^2)$ 

 $Lp=1/(C2(2\pi f)^2)$ 

但し、Ls: 直列インダクタのインダクタンス

Lp:並列インダクタのインダクタンス

C1:誘電体静電容量の値

〇:ガス静電容量の値

f:交流電力の周波数

【請求項7】 並列インダクタと直列に接続され、非放 え、スイ電時にとの並列インダクタの回路を閉じ、放電時にとの た光の3 並列インダクタの回路を開くスイッチング手段を備えた することとを特徴とする請求項6記載のプラズマ発生用電源装 30 源装置。

【請求項8】 放電負荷の負荷電圧を検出する電圧検出 手段を備え、スイッチング手段は該電圧検出手段からの 信号に基づいて前記並列インダクタの回路を開閉することを特徴とする請求項7記載のプラズマ発生用電源装置。

【請求項 9 】 放電負荷の負荷電流を検出する電流検出★

 $Lp=1/(C2(2\pi f)^2)$ 

 $Ls=1/(C1(2\pi f)^2)$ 

但し、Ls:直列インダクタのインダクタンス

Lp: 並列インダクタのインダクタンス

C1:誘電体静電容量の値

CZ:ガス静電容量の値

f:交流電力の周波数

【請求項12】 直列インダクタに過飽和リアクトルを 使用したことを特徴とする請求項11記載のプラズマ発 生用電源装置。

【請求項13】 過飽和リアクトルの飽和条件を放電開始条件に合わせたことを特徴とする請求項12記載のプラズマ発生用電源装置。

2

\* ランスの2次側に接続したことを特徴とする請求項1記 載のプラズマ発生用電源装置。

[請求項3] 並列インダクタ及び直列インダクタをトランスの1次側に接続したことを特徴とする請求項1記載のプラズマ発生用電源装置。

【請求項4】 直列インダクタ及び並列インダクタは、式(1)を満足するインダクタンスを有していることを特徴とする請求項1から請求項3のうちのいずれか1項記載のプラズマ発生用電源装置。

 $\cdot \cdot \cdot (1)$ 

※生用電源装置。

【請求項6】 直列インダクタが式(2)を満足するインダクタンスを有し、並列インダクタは、当該インダクタンスが非放電時には式(3)の値を満足し、放電時には、式(3)の値未満に変化するように構成されたことを特徴とする請求項1から請求項5のうちのいずれか1項記載のプラズマ発生用電源装置。

. . . (2)

 $\cdot \cdot \cdot (3)$ 

★手段を備え、スイッチング手段は該電流検出手段によって検出された電流の変化に基づいて前記並列インダクタの回路を開閉することを特徴とする請求項7記載のブラズマ発生用電源装置。

【請求項10】 放電の発光を検出する光検出手段を備え、スイッチング手段は該光検出手段によって検出された光の変化に基づいて前記並列インダクタの回路を開閉することを特徴とする請求項7記載のプラズマ発生用電源は際

【請求項11】 並列インダクタは式(4)を満足するインダクタンスを有し、直列インダクタは、当該インダクタンスが非放電時には式(5)の値を満足し、放電時には、式(5)の値未満に変化するように構成されたことを特徴とする請求項1から請求項5のうちのいずれか1項記載のプラズマ発生用電源装置。

. . . (4)

...(5)

40 【請求項14】 過飽和リアクトルのコアにフェライト もしくは鉄を用い、過飽和リアクトルが、当該過飽和リ アクトルの両端電圧と電圧印加時間との積が放電開始条 件に合わせて、設定された所定しきい値を超えたときに 磁束が飽和するように構成されていることを特徴とする 請求項13記載のプラズマ発生用電源装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

[発明の属する技術分野] この発明は、オゾン発生器、レーザ発振器などのブラズマ発生用電源装置に関するも50 のである。

#### [0002]

【従来の技術】従来より、オゾン発生器、レーザ発振器などには、プラズマ発生用電源装置が用いられている。図16は、オゾナイザハンドブック(227質、図2.63、コロナ社、昭和35年6月15日発行)に記載された従来のオゾン発生器用のプラズマ発生用電源装置の電源回路図である。との図16において、1は交流の入力電源、2は整流器、3はインバータ、4はトランス(変圧器)、5は電極を有する放電負荷、6は放電負荷5に対して並列に接続された力率改善用の並列インダク10タである。

【0003】次に動作について説明する。入力電源1の 商用の交流電圧は整流器2によって直流に変換され、さ らにインバータ3によって規定の周波数の交流電圧に変 換される。さらにトランス4により放電開始に至る電圧 に昇圧され、放電負荷5に高電圧が印加される。この印 加された高電圧により放電負荷5で放電が発生し、この 放電によりガス粒子が励起される。ここで、放電電極間 に誘電体を挿入した放電負荷を用いた場合、この放電負荷5は電気的にはコンデンサとして働き、電圧に対して 電流の位相が進むことが知られている。このため皮相電 力と有効電力との比である力率が低くなり、放電負荷5 にエネルギーを投入するためには、必要以上の電流を流 す必要がある。

【0004】従って、トランス4や入力電源1を構成する素子は大きな電流に耐えるオーバースペックのものを使用しなければならず、電源装置の大型化、コストの増大要因となる。並列インダクタ6は、放電負荷で電流が進む分を補償するために放電負荷5と並列に接続されたものである。並列インダクタ6は電圧に対し電流の位相 30を遅らす役目を果たす。放電負荷5での電流の進み分と並列インダクタ6による電流の遅れ分を等しく設定する米

 $C = (C1 \times C2/(C1+C2))$ 

#### 但し、C:合成容量の値

【0008】従来のオゾン発生器では、ガス静電容量52の容量値C2に比べて誘電体静電容量51の容量値C1が十分大きくなるように設計されているため、放電発生の有無によらず負荷容量は、常にほぼ値C1となり、共振条件を満たすインダクタンスの値は放電の有無に依存しなかった。

## [0009]

[発明が解決しようとする課題] 従来のプラズマ発生用電源装置は以上のように放電負荷5に対して1種類のインダクタで放電負荷5の静電容量を補償するように構成されているので、たとえば放電ギャップ長を小さく設定した場合のように誘電体静電容量51の値C1に比較してガス静電容量52の値C2が無視できない程度に大きくなった場合には、放電発生の有無により放電負荷5の静電容量が大きく変化し、力率補償ができなくなり、必要以上の容量をもった電気素子を用いる必要が生じる。

\*と電流と電圧の位相が合致し、最も小さい電流で放電負荷5 に効率的にエネルギーを注入することができる。このとき力率は100%となり、いわゆる共振状態となる。

[0005]従来のブラズマ発生用電源装置では、このように放電負荷5と並列に並列インダクタ6を接続することにより、力率を改善し、小容量で安価な電源素子を用い、小型で安価な電源装置を構成している。図16では、トランス4の2次側に並列インダクタ6を接続した場合について示したが、図17に示すようにトランス4の1次側に並列に並列インダクタ62を接続しても同様の効果がある。但し、この場合、耐圧の低い素子を使える反面、トランス4の力率は改善されないという欠点もある。図16に示すように2次側にインダクタを接続した場合には、トランス4を含むすべての力率が改善されるため、有効である。

[0006]次に図18はオゾン発生器など電極間に誘電体を介装した放電負荷5の詳細な等価回路である。との図18において、51は容量値C1を有する電極間の誘電体静電容量、52は容量値C2を有する放電空間のガス静電容量、53はプラズマのオン・オフに伴う非線形性を示すためのツェナーダイオードとしての特性を有するプラズマ負荷である。

[0007] このプラズマ負荷53の抵抗値は、放電電 EV\*未満では無限大となって非放電状態であることを 示し、放電電EV\*以上では、このプラズマ負荷53は 導通状態となって放電状態であることを示す。このため 放電開始前には、放電負荷5は誘電体静電容量51の値 C1とガス静電容量52の値C2が直列に結合して式

(6) によって表される値を有する容量性負荷となり、 放電後は容量値C1単独の容量性負荷となる。

#### . . . (6)

しかし、このような大きな容量を有する電気素子を用いると電源装置が大きくなり、高価になってしまう。従来のブラズマ発生用電源装置には、このように解決しなければならない課題があった。

【0010】との発明は上記のような課題を解決するためになされたもので、放電空間のガスの静電容量が誘電40体の静電容量に比べて無視できないような放電負荷に対しても、力率が高く、小型で安価なブラズマ発生用電源装置を得るととを目的とする。

#### [0011]

【課題を解決するための手段】この発明に係るブラズマ発生用電源装置は、2つの電極間で等価的に誘電体静電容量とガス静電容量とを有し、放電してガスを励起し、ブラズマを発生させる放電負荷に対し、並列に接続された並列インダクタと、直列に接続された直列インダクタとを備えたものである。

【0012】との発明に係るプラズマ発生用電源装置

は、並列インダクタ及び直列インダクタをトランスの2次側に接続したものである。

【0013】この発明に係るプラズマ発生用電源装置 は、並列インダクタ及び直列インダクタをトランスの1\*

 $Lp=Ls=(C1+C2)/(C1\times C2\times (2\pi f)^2)$ 

但し、Lp:並列インダクタのインダクタンス

Ls:直列インダクタのインダクタンス

C1: 誘電体静電容量の値C2: ガス静電容量の値f: 交流電力の周波数

【0015】この発明に係るブラズマ発生用電源装置

は、トランスの漏れインダクタンスを利用して直列イン※

 $Ls=1/(C1(2\pi f)^{2})$ 

 $Lp=1/(C2(2\pi f)^2)$ 

但し、Ls:直列インダクタのインダクタンス

Lp:並列インダクタのインダクタンス

C1: 誘電体静電容量の値 C2: ガス静電容量の値

f:交流電力の周波数

[0017] との発明に係るプラズマ発生用電源装置は、並列インダクタと直列に接続され、非放電時に回路を閉じ、放電時にこの並列インダクタの回路を開くスイッチング手段を備えたものである。

【0018】との発明に係るブラズマ発生用電源装置は、放電負荷の負荷電圧を検出する電圧検出手段を備え、スイッチング手段は該電圧検出手段からの信号に基づいて前記並列インダクタの回路を開閉するものである

【0019】この発明に係るブラズマ発生用電源装置 ★

Lp=1/( $C1(2\pi f)^2$ ) Ls=1/( $C1(2\pi f)^2$ )

但し、Ls: 直列インダクタのインダクタンス

Lp: 並列インダクタのインダクタンス

C1: 誘電体静電容量の値

(2:ガス静電容量の値

f:交流電力の周波数

[0022] この発明に係るプラズマ発生用電源装置は、直列インダクタに過飽和リアクトルを使用したものである。

【0023】との発明に係るプラズマ発生用電源装置は、過飽和リアクトルの飽和条件を放電開始条件に合わせたものである。

【0024】この発明に係るプラズマ発生用電源装置は、過飽和リアクトルのコアにフェライトもしくは鉄を用い、当該過飽和リアクトルの両端電圧と電圧印加時間との積が放電開始条件に合わせて、設定された所定しきい値を超えたときに磁束が飽和するように過飽和リアクトルが構成されているものである。

[0025]

【発明の実施の形態】以下、この発明の実施の一形態を 50 誘電体静電容量、52は容量値C2を有する放電空間の

\*次側に接続したものである。

【0014】この発明に係るプラズマ発生用電源装置は、直列インダクタ及び並列インダクタが、式(1)を満足するインダクタンスを有しているものである。

 $\cdots$  (1)

※ ダクタを構成したものである。

[0016]との発明に係るプラズマ発生用電源装置は、直列インダクタが式(2)を満足するインダクタンスを有し、並列インダクタは、当該インダクタンスが非10 放電時には式(3)の値を満足し、放電時には、式(3)の値未満に変化するように構成されたものであ

...(2)

. . . (3)

★は、放電負荷の負荷電流を検出する電流検出手段を備え、スイッチング手段は該電流検出手段によって検出された電流の変化に基づいて前記並列インダクタの回路を開閉するものである。

[0020] との発明に係るプラズマ発生用電源装置 20 は、放電の発光を検出する光検出手段を備え、スイッチング手段は該光検出手段によって検出された光の変化に 基づいて前記並列インダクタの回路を開閉するものであ

[0021] この発明に係るプラズマ発生用電源装置は、並列インダクタが式(4)を満足するインダクタンスを有し、直列インダクタのインダクタンスが非放電時には式(5)の値を満足し、放電時には、式(5)の値未満に変化するように直列インダクタが構成されたものである。

 $\cdots \cdot (4)$ 

... (5)

説明する。

実施の形態 I. 図 I はこの発明の実施の形態 I によるプラズマ発生用電源装置を示す回路図である。図 I において、1 は交流の入力電源、2 は整流器、3 はインバータ、4 はトランス(変圧器)、5 は電極を有する放電負荷、6 は放電負荷5、トランス4の2次側巻線に対して並列に接続され、インダクタンス L p を有する力率改善用の並列インダクタ、7 は放電負荷5、トランス4の2次側巻線に対して直列に接続され、インダクタンス L s を有する力率補償用の直列インダクタである。

【0026】とのプラズマ発生用電源装置は、例えばオゾン発生器用電源に適用される。但し、これに限られるものではなく、誘電体を介した放電を用いる装置であれば、例えばレーザ、プラズマディスプレーパネル、ランプなど、放電を用いた粒子励起装置にも同じように用いることができる。以下の実施の形態についても同様である

[0027]また、51は容量値C1を有する電極間の 誘環は熱震容器 52は容器値C2を有する電極間の

6

ガス静電容量、53はプラズマのオン・オフに伴う非線 形性のツェナーダイオードとしての特性を有するプラズ マ負荷である。実施の形態 1 は、直列インダクタ7を備 えている点で図Ⅰ6に示す従来の構成と異なっている。 【0028】次に動作について説明する。入力電源1の 商用の交流電圧は整流器2によって直流に変換され、さ らにインバータ3によって規定の周波数の交流電圧に変 換される。さらにトランス4により放電開始に至る電圧 に昇圧され、放電負荷5に高電圧が印加される。 この印 加された高電圧により放電負荷5で放電が発生し、この\*10

Lp=Ls=(C1+C2)/(C1×C2×(2 $\pi$ f)<sup>2</sup>)

但し、Lp:並列インダクタ6のインダクタンス LS: 直列インダクタ7のインダクタンス

f: インバータ3の出力周波数(交流電力の周波数、以 下、同じ)

【0031】以上のように、との実施の形態1によれ は、放電負荷5に対して並列に力率補償用の並列インダ クタ6を、直列に力率補償用の直列インダクタ7を接続 したので、並列インダクタ6を単独に接続した場合より も、放電負荷5の変化に対して安定的に力率を改善する 20 ことができる。特に、式(7)を満足する値を有し、放 電負荷5の合成容量と共振する2つのインダクタを用い ることにより、力率改善度合いを高く設計することがで きるという効果が得られる。

[0032]実施の形態2.図2はこの発明の実施の形※

Lp1=Ls1=(C1+C2)/(C1 $\times$ C2 $\times$ (2 $\pi$ f) $^{2}$ )/ $m^{2}$ 

但し、m:トランス4の巻数比(以下、同じ) [0034]以上のように、この実施の形態2によれ ば、トランスの1次側に直列と並列の力率改善用インダ クタを配置することにより、耐電圧の低い素子を用いる 30 ことができるという効果が得られる。

【0035】実施の形態3.図3はこの発明の実施の形 態3によるプラズマ発生用電源装置を示す回路図であ る。図3に示すように、実施の形態3では放電負荷5、 トランス4の2次側巻線に対して直列に直列インダクタ 7を、トランス4の1次側巻線と並列に並列インダクタ 61を接続している。尚、実施の形態1と同一要素につ いては同一符号を付して説明を省略する。

[0036]次に動作について説明する。この図3に示 すように、トランス4の1次側巻線と並列に接続された 並列インダクタ61のインダクタンスの値をトランス4 の巻数比で変換すれば、実施の形態1と同じLC直並列 回路となる。また、共振回路にするためには、並列イン ダクタ61のインダクタンスの値を式(8)を満足する 値に設定する。

【0037】以上のように、この実施の形態3によれ は、トランスの1次側と2次側に直並列に、それぞれ並 列インダクタ61、直列インダクタ7を接続しても実施 の形態1とほぼ同様の効果が得られる。尚、図示しない がトランス4の1次側巻線に直列インダクタ71を、2 50 【0041】以上のように、この実施の形態4によれ

\* 放電によりガス粒子が励起される。

【0029】図1において、放電負荷5に対して並列イ ンダクタ6だけでなく、直列インダクタ7を接続するこ とにより、並列インダクタ6を単独に接続した場合に比 較して、皮相電力と有効電力との比である力率の改善度 合いが向上する。

【0030】特に並列インダクタ6、直列インダクタ7 のインダクタンスが式(7)をほぼ満足する値である場 合、放電負荷5の合成容量と共振し、90%程度の力率 が得られることが判明した。

 $\cdots$  (7)

※態2によるブラズマ発生用電源装置を示す回路図であ る。図2において、61はトランス4の1次側巻線と並 列に接続され、インダクタンスLp1を有する並列イン ダクタ、71はトランス4の1次側巻線と直列に接続さ れ、インダクタンスLs2を有する直列インダクタであ る。尚、実施の形態1と同一要素については同一符号を 付して説明を省略する。

【0033】次に動作について説明する。トランス4の 1次側巻線と直列に直列インダクタ71を、並列に並列 インダクタ61を接続しても、実施の形態1とほぼ同様 の効果が得られる。この場合、トランス4を介すること になるので、インダクタンスの値を式(3)によって表 される値にすることによって放電負荷5の合成容量と共 振し、インダクタンスの値としては最適となる。

. . . (8)

次側巻線に並列インダクタ6を接続しても同様の効果を 奏するととはいうまでもない。

【0038】実施の形態4. 図4はこの発明の実施の形 態4によるプラズマ発生用電源装置を示す回路図であ る。図4において、72は放電負荷5、トランス4の2 次側巻線に対して等価的に直列接続されたトランス漏れ インダクタンスである。尚、実施の形態1と同一要素に ついては同一符号を付して説明を省略する。

【0039】次に動作について説明する。実施の形態1 では、トランス4の2次側巻線と直列に直列インダクタ 7を接続するようにしたが、この直列インダクタ7の代 わりにもちろんトランス漏れインダクタンス72を用い るようにしても同じように作用する。この場合、トラン ス4の1次側で力率を改善するには、トランス漏れイン ダクタンス72のインダクタンスをLrとして、Ls1 = Lrとすれば良く、トランス4の2次側で力率を改善 するには、トランス4の巻数比mに対して、Ls=m² Lrとすれば良い。

[0040]尚、トランス4の既存の漏れインダクタン スを利用してもよいが、図5に示すようにトランス4の コア41に隙間δを設けて漏れインダクタンスLrを形 成してもよい。この図5において、42はトランス4の 巻線である。

"

ば、漏れインダクタンスLrを利用するようにしたので、この漏れインダクタンスが実施の形態1の直列インダクタ7と同じ役割をすることになり、新たに直列にインダクタを接続する必要がないので、安価な装置を提供することができ、しかも実施の形態1と同じような効果を得ることができる。また、トランス4のコア41に隙間 δを設けることにより、漏れインダクタンスLrを設定することができる。

[0042] 実施の形態5.図6はこの発明の実施の形態5によるブラズマ発生用電源装置を示す回路図である。図6において、並列インダクタ6は、そのインダク\*

# Ls=1/(C1(2 $\pi$ f)<sup>2</sup>) Lp=1/(C2(2 $\pi$ f)<sup>2</sup>)

インダクタンスLpを非放電時に式(10)を満足するような値に設定し、放電時には、Lp=∞となるように設定することが望ましい。

[0044]以上のように、この実施の形態5によれば、放電負荷5の放電に合わせて並列インダクタ6のインダクタンスLpを可変するようにしたので、放電負荷5の放電に関わらず常に力率を改善することができ、放 20電電力によらず高い力率を得ることができるといった効果が得られる。

[0045] 実施の形態6.図7はこの発明の実施の形態6によるプラズマ発生用電源装置を示す回路図である。図7において、8は並列インダクタ6と直列に接続されたスイッチング素子(スイッチング手段)である。尚、実施の形態1と同一要素については同一符号を付して説明を省略する。

[0046]次に動作について説明する。実施の形態6は、実施の形態5をさらに具体的に実現したものであり、放電開始前はスイッチング素子8を導通状態に、放電時には遮断状態に制御する。

[0047]以上のように、この実施の形態6によれば、並列インダクタ6にスイッチング素子8を直列に配置し、放電発生の有無に従ってスイッチング素子8をオン、オフ制御するようにしたので、放電負荷5の放電発生の有無に係わらず常に高い力率を得ることができる。 [0048]実施の形態7.図8はこの発明の実施の形

【0048】実施の形態7.図8はこの発明の実施の形態7によるプラズマ発生用電源装置を示す回路図である。図8において、91は放電負荷5の電圧を計測する電圧検出素子(電圧検出手段)である。尚、実施の形態1と同一要素については同一符号を付して説明を省略する。

【0049】次に動作について説明する。放電負荷5の電圧を計測することにより放電発生の有無を検出することができる。そして、電圧検出素子91により検出された放電負荷5の電圧が所定の放電電圧より低ければスイッチング素子8を導通状態に、この放電電圧よりも高ければスイッチング素子8を遮断状態に制御する。

[0050]以上のように、との実施の形態7によれ

\* タンスLpが可変するように構成されている。

[0043]次に動作について説明する。放電負荷5は 放電することにより、その容量が変化する。これに合わ せて並列インダクタ6のインダクタンスLpも可変す る。さらに完全に力率を補償するためには、直列インダ クタ7のインダクタンスLs、並列インダクタ6のイン ダクタンスLpをそれぞれ式(9)、式(10)を満足 する値に設定することにより、放電のオン、オフに同期 してインダクタンスLpの等価的な値を変化させれば有 30である。

# · · · (9) · · · (10)

ば、電圧検出素子91で放電負荷5の電圧を計測することにより放電発生の有無を正確に検出することができるので、スイッチング素子8に正確な制御信号を送ることができ、精度よく力率を改善することができるといった効果が得られる。

[0051] 実施の形態8.図9はこの発明の実施の形態8によるプラズマ発生用電源装置を示す回路図である。図9において、92は放電負荷5への電流を検出する電流検出素子(電流検出手段)である。尚、実施の形態1と同一要素については同一符号を付して説明を省略する。

[0052]次に動作について説明する。放電負荷5の電流の変化を計測することにより放電の発生の有無を検出することができる。そして、実施の形態7と同様に、電流検出素子92により所定値以上の電流変化が検出されたときは放電発生と判断し、スイッチング素子8を導30 選状態に、また所定値未満のときはスイッチング素子8を遮断状態に制御する。

【0053】以上のように、この実施の形態8によれば、電流検出素子92で放電負荷5の電流の変化を検出することにより放電発生の有無を正確に検出することができるので、スイッチング素子8に正確な制御信号を送ることができ、精度よく力率を改善することができるといった効果が得られる。

[0054] 実施の形態9、図10はこの発明の実施の 形態9によるプラズマ発生用電源装置を示す回路図であ る。図10において、93は放電負荷5の放電による発 光を検出する光検出素子(光検出手段)である。尚、実 施の形態1と同一要素については同一符号を付して説明 を省略する

[0055]次に動作について説明する。放電による発光を検出するととにより放電発生の有無を確認できる。そして、実施の形態7、実施の形態8と同様に、光検出素子93により放電による発光が検出されたときは、スイッチング素子8を導通状態に制御する。

[0056]以上のように、この実施の形態9によれ 50 ば、光検出素子93で放電による発光を検出することに

より放電発生の有無を正確に検出することができるの で、スイッチング素子8に正確な制御信号を送ることが でき、精度よく力率を改善することができるといった効 果が得られる。

【0057】実施の形態10.図11はこの発明の実施 の形態10によるプラズマ発生用電源装置を示す回路図 である。この実施の形態10は、実施の形態6と同じよ ろに並列インダクタ6と直列にスイッチング素子8を接 続し、実施の形態4と同じように直列インダクタ7とし 成したものである。

【0058】次に動作について説明する。実施の形態4 と同じようにトランス漏れインダクタンス72が直列イ ンダクタ7と同じように作用し、スイッチング素子8を 放電に合わせてオン・オフする。尚、トランス4の1次 側で力率を改善するには、Ls1=Lrとすれば良く、 トランス4の2次側で力率を改善するには、トランス4 の巻数比mに対して、Ls=m'Lrとすれば良く、図 5に示すようにトランス4のコア41に隙間δを設けて\*

> $Ls2 = 1/C1(2\pi f)^2)/m^2$  $Lp2 = 1/C2(2\pi f)^{2})/m^{2}$

但し、Ls2:直列インダクタ71のインダクタンス Lp2:並列インダクタ61のインダクタンス

【0062】以上のように、この実施の形態 I1によれ は、並列インダクタ61、直列インダクタ71、スイッ チング素子8をトランス4の1次側に配置しても実施の 形態1、6と同様の効果を得ることができ、しかも実施 の形態2と同様に耐電圧の低い素子を用いることもでき 3.

[0063]実施の形態12.図13はこの発明の実施 30 の形態12によるプラズマ発生用電源装置を示す回路図 である。図13において、73は放電負荷5、トランス 4の2次側巻線に対して直列に接続されてインダクタン スが可変する直列インダクタである。尚、実施の形態1※

> $Lp3=1/(C1(2\pi f)^2)$ Ls3=1/(C2(2 $\pi$ f)<sup>2</sup>)

但し、Ls3: 直列インダクタ73のインダクタンス Lp3:並列インダクタ61のインダクタンス 理想的には、非放電時に式(14)を満足し、放電時に は、Ls3=0となることが望ましい。

[0065]以上のように、この実施の形態12によれ は、放電負荷5に対して直列インダクタ73の容量を変 化するようにしたので、放電電力によらず高い力率を得 ることができるといった効果を得ることができる。

【0066】実施の形態13.図14はこの発明の実施 の形態13によるプラズマ発生用電源装置を示す回路図 であり、との実施の形態13は、直列インダクタを過飽 和リアクトルとして構成したものである。図14におい て、74は放電負荷5、トランス4の2次側巻線に対し て直列に接続された過飽和リアクトルとしての過飽和イ \*漏れインダクタンスしrを形成することもできる。

[0059]以上のように、この実施の形態10によれ ば、スイッチング素子8を備え、さらにトランス漏れイ ンダクタンス72を利用することにより、実施の形態 4,6と同様の効果を得ることができる。

[0060]実施の形態11.図12はこの発明の実施 の形態11によるプラズマ発生用電源装置を示す回路図 である。図12に示すように、並列インダクタ61と直 列インダクタ71とはトランス4の1次側に配置され、 てトランス漏れインダクタンス72を利用するように構 10 スイッチング素子8が並列インダクタ61と直列に接続 されている。尚、実施の形態1と同一要素については同 一符号を付して説明を省略する。

> 【0061】次に動作について説明する。実施の形態2 と同様に、力率改善用の直列インダクタ、並列インダク タをトランス4の2次側に設置する必要はない。この場 合においても、並列インダクタ61、直列インダクタ7 1には、それぞれ式(11)、式(12)で表されるイ ンダクタンスに設定することにより共振回路を構成する ことができる。

> > $\cdots$  (11)  $\cdots$  (12)

※と同一要素については同一符号を付して説明を省略す

【0064】次に動作について説明する。実施の形態5 において説明したように放電負荷5は放電することによ り、その容量が変化する。実施の形態5では、これに合 わせて並列インダクタ6のインダクタンスLpを可変す るようにしたが、実施の形態12では、直列インダクタ 73のインダクタンスを可変するようにする。また、並 列インダクタ61、直列インダクタ73にそれぞれ式 (13)、式(14) に表されたインダクタンスをほぼ 満足するようにして、放電のオン、オフに同期して直列 インダクタ73の等価的な値を変化させる方法も有効で ある。

> $\cdots$  (13)  $\cdot \cdot \cdot (14)$

ンダクタである。この過飽和インダクタ74のコアをフ ェライトもしくは鉄等によって構成する。また、この過 飽和インダクタ74の磁束の飽和条件を放電の開始条件 と一致させるようにしておく。即ち、図15に示すよう に、過飽和インダクタ74の磁束が飽和する電圧時間積 Vtのしきい値VtOを、放電開始と一致するように設 定しておく。尚、実施の形態1と同一要素については同 一符号を付して説明を省略する。

[0067]次に動作について説明する。図15に示す ように、過飽和インダクタ74の両端の電圧vと時間t の積がしきい値VtO以下であるときは、過飽和インダ クタ74の磁束は非飽和となる。非飽和状態でのインダ クタンスは式(11)によって表される。過飽和インダ 50 クタ74の磁束の飽和条件を放電の開始条件と一致して いるので、放電負荷5の放電が開始すると過飽和インダクタ74の両端の電圧vと時間tの積がしきい値VtOを超え、過飽和インダクタ74の磁束が飽和する。飽和状態では過飽和インダクタ74のインダクタンスが変化してLs3=0となる。

13

【0088】以上のように、この実施の形態13によれば、過飽和リアクトルを用いてインダクタンスを変化させることができ、スイッチング素子8を設ける必要がなくなり、安価な電源システムを供給できるといった効果が得られる。また、放電の開始条件と磁束の飽和条件が10一致しているため、放電が開始すると、電圧と時間の積で自然に磁束が飽和し、効率の高い電源システムを供給できる。

[0069]

【発明の効果】以上のように、との発明によれば、放電 負荷に対して並列に接続された並列インダクタと、前記 放電負荷に対して直列に接続された直列インダクタとを 備えて構成したので、並列インダクタ単独の場合より も、放電負荷の変化に対して安定な力率改善が可能にな り、誘電体の静電容量に対してガスの静電容量が無視で きないような装置においても、力率を高くすることがで き、小型で安価な電源装置を得ることができるといった 効果を得ることができる。

【0070】この発明によれば、並列インダクタ及び直列インダクタをトランスの2次側に接続するように構成したので、トランスの2次側に配置された放電負荷との間で直接作用し、力率を向上させることができる効果がある。

[0071] この発明によれば、並列インダクタ及び直列インダクタをトランスの1次側に接続したように構成したので、耐電圧の低い素子を用いることができる効果がある。

[0072] との発明によれば、直列インダクタ及び並列インダクタは、式(1)を満足するインダクタンスを有し、放電負荷の合成容量と共振するように構成したので、力率の改善度合いを高く設計することができる効果がある。

【0073】との発明によれば、直列インダクタはトランスの漏れインダクタンスを利用するように構成したので、新たに直列にインダクタを入れる必要がなく、安価な装置を提供することができる効果がある。

[0074] との発明によれば、直列インダクタ式

(2)を満足するインダクタンスを有し、並列インダクタは、当該インダクタンスが非放電時には式(3)の値を満足し、放電時には、式(3)の値未満に変化するように構成したので、放電電力によらず高い力率を得ることができる効果がある。

【0075】との発明によれば、並列インダクタと直列 に接続され、非放電時にこの並列インダクタの回路を閉 じ、放電時に回路を開くスイッチング手段を備えるよう に構成したので、放電発生の有無に係わらず常に高い力 率を得ることができる効果がある。

[0076] この発明によれば、放電負荷の負荷電圧を検出する電圧検出手段を備え、スイッチング手段は該電圧検出手段からの信号に基づいて前記並列インダクタの回路を開閉するように構成したので、放電発生の有無を正確に検出することができる。従って、スイッチング手段に正確な制御信号を送ることができ、精度よく力率を改善することができるといった効果が得られる。

【0077】この発明によれば、放電負荷の負荷電流を検出する電流検出手段を備え、スイッチング手段は該電流検出手段によって検出された電流の変化に基づいて前記並列インダクタの回路を開閉するように構成したので、放電発生の有無を正確に検出してスイッチング手段に正確な制御信号を送ることができ、精度よく力率を改善することができるといった効果が得られる。

【0078】この発明によれば、放電の発光を検出する 光検出手段を備え、スイッチング手段は該光検出手段に よって検出された光の変化に基づいて前記並列インダク タの回路を開閉するように構成したので、放電発生の有 無を正確に検出してスイッチング手段に正確な制御信号 を送ることができ、精度よく力率を改善することができ るといった効果が得られる。

[0079] この発明によれば、並列インダクタは式 (4)を満足するインダクタンスを有し、直列インダク タは、当該インダクタンスが非放電時には式(5)の値 を満足し、放電時には、式(5)の値未満に変化するよ うに構成したので、放電電力によらず高い力率を得るこ

とができる効果がある。

50

【0080】この発明によれば、直列インダクタに過飽 和リアクトルを使用するように構成したので、安価な電 源装置を供給することができる効果がある。

[0081]との発明によれば、過飽和リアクトルの飽和条件を放電開始条件に合わせるように構成したので、効率の高い電源システムを供給することができる効果がある。

【0082】この発明によれば、過飽和リアクトルのコアにフェライトもしくは鉄を用い、当該過飽和リアクトルの両端電圧と電圧印加時間との積が放電開始条件に合わせて、設定された所定しきい値を超えたときに磁束が飽和するように過飽和リアクトルが構成されているので、電圧と時間の積で自然に磁束が飽和し、スイッチング手段を用いないでもインダクタンスを変化させることができ、安価な電源システムを供給できる効果がある。【図面の簡単な説明】

【図1】 この発明の実施の形態1によるプラズマ発生 用電源装置を示す回路図である。

【図2】 との発明の実施の形態2によるブラズマ発生 用電源装置を示す回路図である。

【図3】 との発明の実施の形態3によるプラズマ発生

用電源装置を示す回路図である。

【図4】 この発明の実施の形態4によるブラズマ発生 用電源装置を示す回路図である。

【図5】 図4のトランスを示す模式図である。

【図6】 この発明の実施の形態5によるプラズマ発生 用電源装置を示す回路図である。

【図7】 この発明の実施の形態6によるブラズマ発生 用電源装置を示す回路図である。

【図8】 この発明の実施の形態7によるブラズマ発生 用電源装置を示す回路図である。

【図9】 この発明の実施の形態8によるプラズマ発生 用電源装置を示す回路図である。

[図10] この発明の実施の形態9によるプラズマ発生用電源装置を示す回路図である。

【図11】 この発明の実施の形態10によるプラズマ 発生用電源装置を示す回路図である。

【図12】 この発明の実施の形態11によるプラズマ 発生用電源装置を示す電源回路図である。 \*【図13】 この発明の実施の形態12によるブラズマ 発生用電源装置を示す回路図である。

【図14】 との発明の実施の形態13によるプラズマ 発生用電源装置を示す回路図である。

【図15】 図14の過飽和インダクタの磁束の非飽和、飽和状態を示す説明図である。

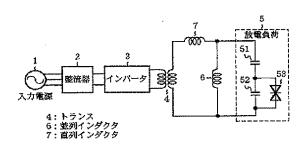
[図 1 6 ] 従来のプラズマ発生用電源装置を示す回路 図である。

【図17】 従来の別のプラズマ発生用電源装置を示す 10 回路図である。

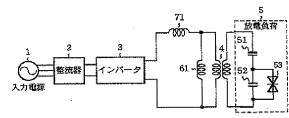
【図18】 放電負荷の等価回路を示す図である。 【符号の説明】

4 トランス、5 放電負荷、6,61 並列インダクタ、7,71,73直列インダクタ、8 スイッチング素子(スイッチング手段)、74 過飽和インダクタ(過飽和リアクトル)、91 電圧検出素子(電圧検出手段)、92電流検出素子(電流検出手段)、93 光検出素子(光検出手段)。

[図1]

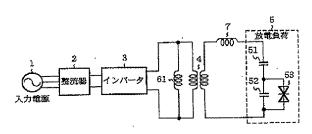


[図2]

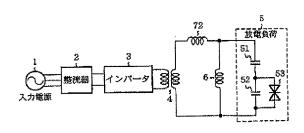


71: 資別インダクタ

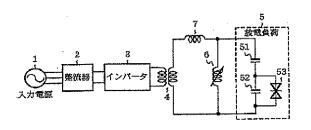
[図3]



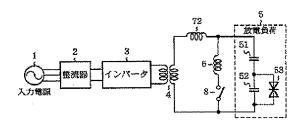
【図4】

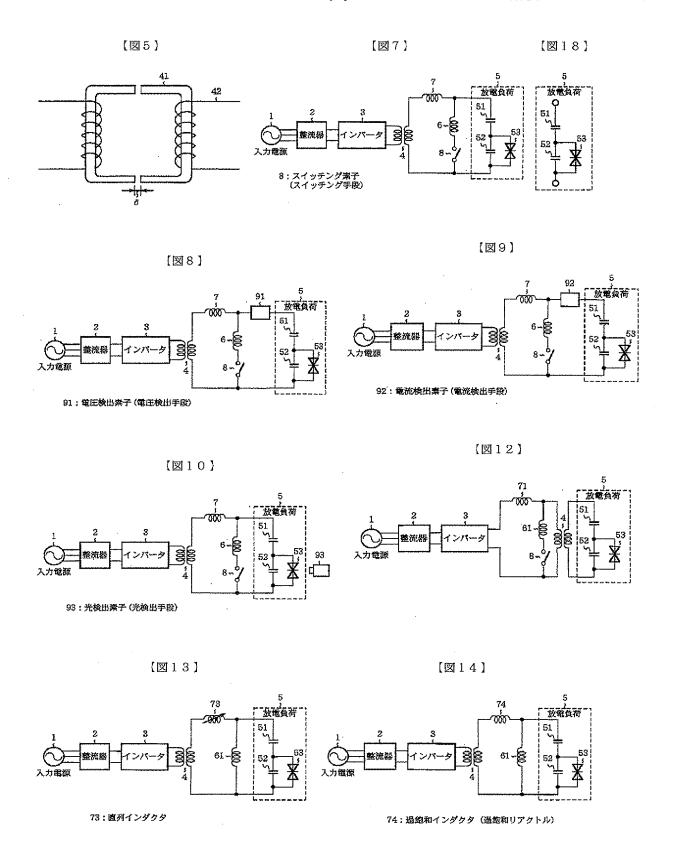


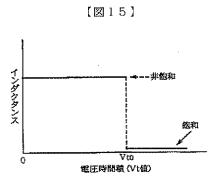
[図6]

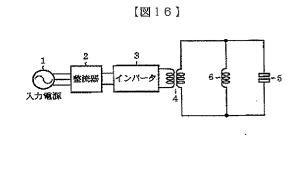


【図11】









[図17]

